## Медь-кислородные субструктуры в аллотропных формах углерода (графит и фуллерен)

© В.Ф. Мастеров, А.В. Приходько, Т.Р. Степанова, А.А. Шакланов, О.И. Коньков

Санкт-Петербургский государственный технический университет, 195251 Санкт-Петербург, Россия

(Поступила в Редакцию 1 июля 1998 г.)

Проведены сравнительные исследования проводимости и структуры кристаллического графита и фуллереновых мембран, допированных медью. Предполагается, что кластеры C<sub>60</sub> образуют с кислородом и медью комплексы, аналогичные существующим в графите. Эти комплексы при температурах выше комнатной, во-первых, изменяют симметрию кристаллической решетки фуллеренов, и во-вторых, ответственны за немонотонное поведение зависимости электрического сопротивления от температуры.

Обнаруженный ранее экспериментальный факт, что десорбция кислорода приводит к увеличению сопротивления порошкообразных образцов графита и фуллерена  $C_{60}$  [1], свидетельствует об электрической активности молекулярного кислорода, сорбированного на поверхности гранул, который может влиять на электронную плотность у границ гранул и изменять условия протекания тока через поверхностные барьеры.

Предполагалось, что при температурах, близких к комнатной в порошкообразных структурах на основе графита и фуллерена, реализуется перколяционная проводимость по бесконечному кластеру. При повышении температуры молекулярный кислород постепенно перестает быть связанным на границе гранул и при критической температуре Т<sub>с</sub> происходит разрушение бесконечного проводящего кластера, что приводит к росту сопротивления и изменению характера вольтамперных характеристик. Близкие значения температурных порогов перколяции для обеих аллотропных форм углерода могут быть обусловлены схожими значениями энергии связи молекул кислорода на границах гранул графита и фуллерена. В фуллеритах кислород связывается на гексагонах молекул В то же время подобные углеродные гек- $C_{60}$  [2]. сагоны являются основными элементами, образующими плоскости графита. Очевидно, что в образцы графита с большим размером гранул или рыхлого (слабосжатого) фуллерена молекулы кислорода проникают практически по всему объему образца и повышение температуры приводит только к десорбции кислорода. Этот эффект выражается в плавном росте сопротивления.

Наряду с интеркалированными атомами кислорода на гексагонах могут существовать и другие атомы, например, медь [3]. При этом в межплоскостном пространстве графита образуются двумерные слои CuO, а фуллерены, возможно, трансформируются в гиперкластеры, покрытые CuO [4]. В данной работе приведены результаты сравнительных исследований проводимости и структуры кристаллического графита, интеркалированного медью и кислородом, а также поликристаллических фуллереновых медьсодержащих образцов [5].

## 1. Образцы и методика

В качестве образцов использовался высокоориентированный пиролитический графит (HOPG), интеркалированный медью [3], а также поликристаллические фуллереновые медьсодержащие образцы (C<sub>60</sub>/C<sub>70</sub>) : Cu, изготовленные с применением модифицированного процесса сублимации исходного фуллеренового порошка в термокамере малых размеров [5]. Интеркалирование медью образцов HOPG осуществлялось их двадцатиминутной выдержкой в расплаве меди чистоты 9.99% при  $T = 1473 \,\mathrm{K}$  в вакууме не хуже  $10^{-3} \,\mathrm{Torr.}$  Maccспектрометрический анализ, проведенный для исходного фуллеренового порошка, выявил содержание С<sub>60</sub>-67%, C<sub>70</sub>-28%, C<sub>76,78,84</sub>-2% (порошок изготовлен и аттестован в рамках Государственной программы "Фуллерены и атомные кластеры"). Медь вводилась в исходный порошок в соотношении 1 : 1. Масс-спектрометрические исследования выявили содержание меди в графитовых и фуллереновых образцах в пределах 10<sup>-3</sup> %. Сопротивление образцов R измерялось с использованием метода наносекундной вольтамперметрии по регистрации падающего  $(U_i)$  и отраженного импульса  $(U_r)$  напряжения, когда разогрев образцов в процессе измерения минимален [6]. При достаточно больших величинах сопротивления образцов  $(R/\rho \ge 10^2)$ , где  $\rho$  — волновое сопротивление коаксиальной линии) производилась только качественная оценка поведения *R* на основе регистрации переходных процессов пs-длительности. При этом учитывалось, что крутизна нарастания импульса, отраженного от образца, эквивалентна постоянной времени [6].

Сопротивление образца рассчитывалось по формуле  $R = \rho(U_i + U_r)/(U_i - U_r)$ , где  $U = U_i + U_r$  — напряжение на образце,  $I = (U_i - U_r)/\rho$ .

Изменение крутизны фронта импульса регистрировалось по амплитуде фронта импульса  $U_f \sim 1/R$  в определенной точке переднего фронта (0.45 ns). Длительность

фронта импульса напряжения составляла 0.5 ns. Измерения проводились в вакууме  $10^{-3}$  Torr и температурном интервале 290–400 K.

Рентгеноструктурный анализ образцов проводился с использованием дифрактометрической системы "Geigerflec" на  $CuK_{\alpha}$  излучении.

## 2. Результаты и обсуждение

На рис. 1 приведены результаты исследования влияния интеркалированного кислорода на сопротивление медьсодержащих образцов кристаллического графита (рис. 1, a) и фуллереновых образцов (рис. 1, b). Для исходных образцов НОРС при увеличении температуры выше 330 К сопротивление возрастает, причем температура  $T_{c_0} = 360 \,\mathrm{K}$  (кривая 1 на рис. 1, *a*) практически совпадает с температурой окончания десорбции кислорода из порошкообразного графита [1]. Тогда как для образцов (HOPG): Си значение  $T_{c_1} = 306 \,\mathrm{K}$  совпадает с величиной десорбционного пика (305-310 К), который появляется в мелкодисперсном плотном материале. Кроме того, обнаружена особенность — появление второй десорбционной температуры T<sub>c2</sub> = 312 К. Следовательно, десорбционный процесс происходит в два этапа. Первый — соответствует кристаллическому графиту, второй — регистрируется при введении меди. На рис. 2 представлена зависимость R(U), свидетельствующая об



**Рис. 1.** Зависимость R(T) для образцов HOPG(Cu) (*a*) и R(T) для образцов (C<sub>60</sub> / C<sub>70</sub>):Cu (*b*). 1 — кривые соответствуют исходным образцам: для (*a*) — HOPG, для (*b*) — (C<sub>60</sub> / C<sub>70</sub>).



Рис. 2. Зависимость R(U) для образцов HOPG  $(1 - T_0 = 297 \text{ K}, 2 - T_{c_0} = 360 \text{ K}),$  HOPG(Cu)  $3 - T_{c_1} = 306 \text{ K}, 4 - T_{c_2} = 312 \text{ K}).$ 



Рис. 3. Зависимость  $I\rho = f(U)$  для образцов HOPG  $(1 - T_0, 2 - T_c)$ , HOPG(Cu)  $(3 - T_0, 4 - T_{c_1} = 306$  K,  $5 - T_{c_2} = 312$  K)

изменении сопротивления образцов HOPG и HOPG(Cu) при достижении критических температур  $T_c$ . Изменение вольтамперных характеристик в координатах ( $I\rho$  и U) при  $T_c$  показано на рис. 3.

Для образцов  $(C_{60}/C_{70})$ : Си регистрируется резкое изменение крутизны фронта импульса напряжения  $U_f$ , отраженного от образца, примерно при 310 К (кривая 2 на рис. 1, *b*). Из сравнения кривых на рис. 1, *a*, *b* следует, что существует корреляция процесса начала десорбции кислорода в данном образце с началом десорбции в медьсодержащем графите при  $T_{c2} = 312$  К. Для исходных образцов  $(C_{60}/C_{70})$  наблюдается увеличение сопротивления при 320 К, что обусловлено, по нашему мнению, резким увеличением поверхностного сопротивления на частоте 1 GHz в образцах кристаллического графита [3].

Производился сравнительный анализ рентгенограммы исходных фуллереновых образцов C<sub>60</sub>/C<sub>70</sub> и (C<sub>60</sub>/C<sub>70</sub>):Cu, а также рентгенограммы HOPG и HOPG(Cu) (рис. 4). Как видно из рис. 4, *a*, структура фуллереновых образцов является поликристаллической без заметных признаков аморфной фазы, тип решетки в обоих случаях — ГЦК. Для C<sub>60</sub>/C<sub>70</sub>, как следует



Рис. 4, *а*. Ренттенограмма для фуллереновых образцов  $(C_{60}/C_{70})$ . На вставке — изменение рентгеновских максимумов при  $2\theta = 26 - 29^{\circ}$  для  $1 - (C_{60}/C_{70}), 2 - (C_{60}/C_{70})$ : Си.



Рис. 4, b. Рентгенограмма для образцов HOPG: (Cu)

из анализа рентгеновских данных, основной структурой является ГЦК-решетка с параметром *a* = 14.308 Å. Для  $(C_{60}/C_{70})$ : Си наблюдается расщепление рентгеновских максимумов, отвечающих структуре с параметрами a = 14.42 и 14.47 Å (вставка на рис. 4, *a*). Расщепление рефлексов означает появление тетрагональности, т.е. начало перехода из ГЦК-структуры в структуру более низкой симметрии. Исходный графит НОРС представляет из себя монокристалл политипа 2Н с линиями (0002) и (0004)  $d_{0004} = 1.681$  Å (параметр решетки c = 6.725 Å). Структура графита с медью представляет также политип 2H, но кроме линий (0002) и (0004) есть линия (0001) и узкий рефлекс  $d_{1n} = 2.371 \,\text{\AA}$  $(2\theta = 37.5^{\circ})$ , не принадлежащий никакому известному политипу графита (рис. 4, *b*). Параметр решетки графита с медью  $d_{0004} = 1.680$  Å (c = 6.720 Å). Уменьшение параметра решетки в образцах с медью сопровождается уменьшением областей когерентного рассеяния (ОКР). Следовательно, в образце прошла релаксация напряжений, сопровождающаяся диффузией атомов меди в кристалле. Возможно поэтому распределение медной

примеси носит регулярный характер, отсюда и появление пика (0001). Кроме того, часть атомов меди вступает в реакцию с кислородом, растворенном в графите, в результате чего образуются сложные комплексы с атомами решетки графита. Взаимодействия этих комплексов с дефектами решетки приводит к появлению субструктурного рефлекса с периодом 2.371 Å.

Таким образом, можно предположить что, во-первых, медь и кислород образуют сложные комплексы с решеткой графита, и во-вторых, что молекулы С<sub>60</sub> образуют с кислородом и медью комплексы, по-видимому, аналогичные существующим в графите. Эти комплексы при температурах выше комнатной изменяют симметрию кристаллической решетки фуллеренов, а также ответственны за появление десорбционных особенностей захваченного в процессе изготовления образцов кислорода. Известно, что углеродная гексагональная сетка может быть представлена как макромолекула ароматического ряда [7]. При этом краевые места сетки, или области неупорядоченного расположения атомов, образуют связи типа С-ОН, к которым и могут присоединяться атомы меди и кислорода. Включение таких кислородных комплексов в гексагональную сетку приведет к изменению зонной структуры кристалла, нарушению электронной плотности смежных углеродных атомов, что может обусловливать особенности поведения проводимости образцов не только при высоких, но и при низких температурах.

Работа поддержана Научным Советом по направлению "Фуллерены и атомные кластеры" (проект 98063 "Градиент") и Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 96-02-16886а).

## Список литературы

- В.Ф. Мастеров, А.В. Приходько, Н.И. Немчук, А.А. Шакланов, О.И. Коньков. ФТТ **39**, *9*, 1703 (1997).
- [2] H. Werner, M. Wohlers, D. Bublak, Th. Belz, W. Bensch, R. Schlogle. Electronic Properties of Fullerenes / Ed. H. Kusmany, J. Fink, V. Mehring. S. Roth. Spinger-Verlag, Berlin — Heidelberg (1993). P. 16.
- [3] В.Ф. Мастеров, А.В. Приходько, О.И. Коньков, А.А. Шакланов. ФТТ 39, 1, 97 (1997).
- [4] M.D.N. Regueiro, M.N. Regueiro. Recent advances in the chemistry and physics of fullerenes and related materials / Ed. K. M. Kadish, R.S. Ruoff. The Electrochemical Soc. Inc. 94–24 (1994). P. 647.
- [5] В.Ф. Мастеров, А.В. Приходько, Т.Р. Степанова, В.Ю. Давыдов, О.И. Коньков. ФТТ 40, 3, 580 (1998).
- [6] В.Ф. Мастеров, А.В. Приходько, О.И. Коньков, Е.И. Теруков. ФТТ 38, 6, 1687 (1996).
- [7] А.Р. Уббелоде, Ф.А. Льюис. Графит и его кристаллические соединения. М. (1965). С. 119.